## 検出器との結合強化によるマイクロ波多重読出回路の低雑音化

Noise Reduction in Microwave Multiplexers by Tight Coupling to Detectors

産総研<sup>1</sup>, 宇宙航空研究開発機構<sup>2</sup> 中島 裕貴<sup>1,2</sup>, <sup>0</sup>神代 暁<sup>1</sup>, 平山 文紀<sup>1</sup>,

山森 弘毅1, 永沢 秀一1,山崎 典子2,満田 和久2

AIST<sup>1</sup>, JAXA<sup>2</sup> Y. Nakashima<sup>1, 2</sup>, °S. Kohjiro<sup>1</sup>, F. Hirayama<sup>1</sup>,

H. Yamamori<sup>1</sup>, S. Nagasawa<sup>1</sup>, N. Y. Yamasaki<sup>2</sup>, K. Mitsuda<sup>2</sup>

E-mail: s-kohjiro@aist.go.jp

はじめに 計数率増大・短時間イメージングを 目指した多画素化が超伝導検出器研究の潮流 となって久しい。多画素検出器の読出配線数と 配線経由の極低温への流入熱低減のための超 伝導多重読出回路は、その鍵技術である。マイ クロ波帯周波数多重法(MW-Mux)は、他の多重 法に比べ広帯域ゆえ、1本の読出線への多重化 画素数を稼げる。一方、読出雑音√S<sub>I</sub>[A/√Hz]の 報告値[1]は、DC-SOUID の単画素読出の値に 比べ1 桁悪い。MW-Mux では、 画素と 1:1 対応 のマイクロ波共振器を終端する RF-SQUID で はなく、共振器群を束ねる読出線出力端の冷却 高電子移動度トランジスタ(HEMT)増幅器の雑 音が、白色読出雑音の支配要因となる。ゆえに、 検出器-SQUID 結合度(SQUID リング Ls-入力 コイル L<sub>I</sub>間相互インダクタンス M)の増大に より、S<sub>I</sub>低減が見込まれる。M は座金型リング 上のストリップ線路型入力コイルの巻数 N に ほぼ比例するが、DC-SQUID では N 増大に伴 い、標記構造が電圧状態のジョセフソン接合の 発振に対する共振器(共振周波数 fc)を構成し [2]、特性の歪・雑音増大・動作不安定が報告 された。MW-Mux では、この現象を回避し M 増大による SI 低減に成功したので、報告する。

<u>実験</u> A(*M*=60 pH, *N*=7), B(*M*=370 pH, *N*=11)の 2 種の MW-Mux チップを設計・試作し、S<sub>I</sub> と マイクロ波透過率 S<sub>21</sub>の周波数 f 依存性を測定



Fig. 1 (a) Transmission  $|S_{21}|$  vs. frequency *f* of 8 pixels with *M*=370 pH. (b)  $|S_{21}|$ -*f* of pixel-5 with various  $\Phi$ . Thick black and red lines correspond to  $\Phi=n\Phi_0$ and  $(n+1/2)\Phi_0$ , respectively, where *n* is the integer.

した。Bの|S21|-f特性をFig.1に示す。L1全長が 線路内波長の3.8倍@ f=4.9 GHz にも関わらず、 A 同様、下に凸の単調な特性と SQUID への印 加磁束Φに対する円滑な変化を示した。両者の √*S*<sub>I</sub>-*f* 特性を Fig.2 に示す。白色雑音域にて、*M* に反比例した $\sqrt{S_I}$ 低減および B では $\sqrt{S_I}$  <検出器 雑音(JAXA 超伝導転移端センサ)にも成功した。 考察 臨界電流 210 付近に電流バイアスした抵 抗  $R_N/2$  の DC-SOUID では、半磁束量子 $\Phi_0/2$  の Φ変化に対し、ジョセフソン発振周波数(接合 電圧に比例) が0から I<sub>0</sub>R<sub>N</sub>/Φ<sub>0</sub>付近まで変化す る。ゆえに 0<fc<I<sub>0</sub>R<sub>N</sub>/Φ<sub>0</sub> を満たす構造起因の共 振が特性に影響する。一方、MW-Mux の S<sub>21</sub>-f 特性中、Φ変化の影響を受けるf領域の比率は、 共振周波数変化\deltaf<sub>R</sub>(Fig.1b)とf<sub>R</sub>が隣接する画素 間共振周波数差Δf<sub>R</sub>(Fig.1a)の比で求められる。

$$\frac{\delta f_R}{\Delta f_R} \approx \frac{1}{20Q_T} \frac{f_R}{f_{SM}}$$

但し、 $Q_T$ は負荷 Q 値、 $f_{SM}$ は1画素の最大信号 周波数である。典型値  $f_{R}\approx 5$  GHz,  $f_{SM}\approx 1$  MHz,  $Q_T\approx 5\times 10^3$ を代入し、 $\delta f_R/\Delta f_R\approx 1/20$ を得る。す なわち、 $f_C$ を $\delta f_R$ 域外に設計すれば、構造起因 の共振は SQUID 動作に影響しない。

**謝辞** 科研 JP18H01260, JST-CREST JPMJC17N4 文献 [1] D. Bennet et al., IEEE TAS, **25**, 2101405 (2015). [2] K. Enpuku et al., J. Appl. Phys., **71**, 2338 (1992).



Fig. 2 Spectral density of current noise  $\sqrt{S_1}$  with M =60 and 370 pH. Pink line denotes noise of a transition edge sensor fabricated in JAXA.